

2SB850

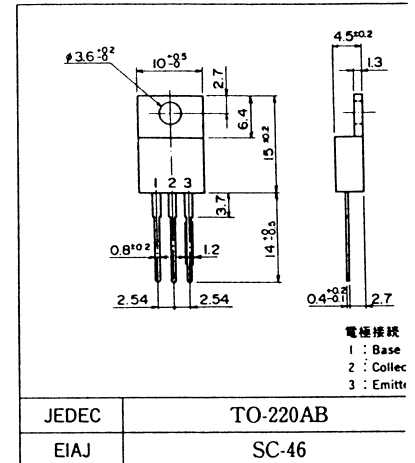
PNPエピタキシャルプレーナ形

一般電力増幅用

EPITAXIAL PLANER TYPE

GENERAL PURPOSE POWER AMPLIFIER

■外形寸法：Outline Drawing



■特長：Features

- h_{FE} のリニアリティが良い Excellent linearity in h_{FE}
- 大電流である High collector current
- ASOが広い Excellent safe operating area
- 高信頼性 High reliability

■用途：Applications

- オーディオ出力 Audio amp
- シリーズレギュレータ Series regulators
- 一般電力増幅 General purpose power amplifiers
(2SD1117とコンプリメンタリになります Complementary to 2SD1117)

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings ($T_c=25^\circ\text{C}$)

Items	Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-7	V
コレクタ電流	I_C	-10	A
ベース電流	I_B	-2	A
コレクタ損失	P_C	50	W
接合温度	T_j	+150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

●電気的特性：Electrical Characteristics ($T_c=25^\circ\text{C}$)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Un
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	$I_{CB0} = -100\mu\text{A}$	-40			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	$I_{CE0} = -10\text{mA}$	-40			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	$I_{EB0} = -100\mu\text{A}$	-7			V
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB0} = -40\text{V}$			-10	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB0} = -7\text{V}$			-10	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$I_C = -2\text{A}, V_{CE} = -5\text{V}$	40	120	240	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -5\text{A}, I_B = -0.5\text{A}$			-1.2	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$				-2.0	V

●熱的特性：Thermal Characteristic

Item	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Un
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Junction to Case			2.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$

NJ Semi-Conductors reserves the right to change test conditions, parameter limits and package dimensions without notice. Information furnished by NJ Semi-Conductors is believed to be both accurate and reliable at the time of going to press. However NJ Semi-Conductors assumes no responsibility for any errors or omissions discovered in its use. NJ Semi-Conductors encourages customers to verify that datasheets are current before placing orders.

